

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成31年1月10日 (2019.1.10)

【公開番号】特開2018-10929(P2018-10929A)

【公開日】平成30年1月18日 (2018.1.18)

【年通号数】公開・登録公報2018-002

【出願番号】特願2016-137730(P2016-137730)

【国際特許分類】

H 0 1 L 25/07 (2006.01)

H 0 1 L 25/18 (2006.01)

H 0 1 L 23/36 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 25/04 C

H 0 1 L 23/36 C

【手続補正書】

【提出日】平成30年11月19日 (2018.11.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

第 1 金属パターン 1 2 b には第 1 金属接合材 1 6、2 0 で半導体チップ 1 8、2 2 が固定されている。半導体チップ 1 8、2 2 は S i C によって形成されている。半導体チップ 1 8 は例えば I G B T (Insulated Gate Bipolar Transistor) であり、半導体チップ 2 2 は例えば還流ダイオードである。S i C によって形成された半導体チップ又はウエハの厚みは 0 . 2 5 mm ~ 0 . 3 5 mm とすることが一般的である。例えば、特開 2 0 1 4 - 8 2 3 6 1 号公報の明細書段落 0 0 0 5 には n 型 S i C ウエハの厚さが 3 5 0 μ m であることが開示されている。本発明の実施の形態 1 に係る半導体モジュールの半導体チップ 1 8、2 2 の厚み Z 2 は 0 . 2 5 mm 以上 0 . 3 5 mm 以下とした。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 図 4 】

